

# 2SD478

シリコン NPN 三重拡散形

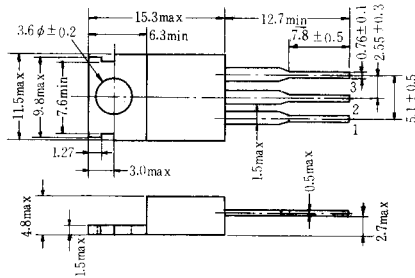
TV垂直偏向出力用

2SB568とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

TV VERTICAL DEFLECTION OUTPUT

Complementary pair with 2SB568



(JEDEC TO-220AB)

1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector  
(フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter  
(Dimensions in mm)

## アクセサリ Accessories

スペーサ	Spacer	SK16B
ワッシャ	Washer	YC20A YZ033S

## ■最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SD478	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	200	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	150	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	6	V
コレクタ電流	$I_C$	2	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	5	A
許容コレクタ損失	$P_C$	1.8	W
	$P_{C^*}$	30	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-45 ~ +150	$^\circ\text{C}$
リード温度(耐ハンダ熱)	$T\theta^{**}$	260	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

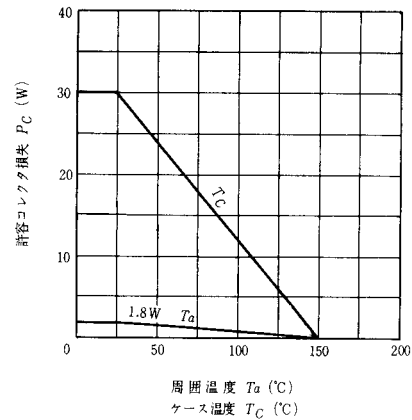
\*\* レジン本体から1.5mm以上離れたリード端子部分において10sec以内における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

\*\* Value at distance 1.5mm from case for 10sec max.

許容コレクタ損失の周囲温度、ケース温度による変化

## MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	150	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=5\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=120\text{V}, I_E=0$	—	—	1	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE1}^*$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=50\text{mA}$	60	—	320	
	$h_{FE2}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=500\text{mA}$	60	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=50\text{mA}$	—	—	1.0	V
2次破壊電流	$I_M$	$V_{CE}=120\text{V}, 50\text{Hz Half Wave}, 30\text{Pulses}$	0.6	—	—	A
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=100\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	22	—	pF

\*2SD478は  $h_{FE1}$  の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

\*The 2SD478 is grouped by  $h_{FE1}$  as follows.

Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60~120	100~200	160~320